УДК 537.874.72

# ЧАСТОТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ РАДИОВОЛН В НАНОКОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ ОПАЛОВЫХ МАТРИЦ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ ФЕРРИТОВ-ШПИНЕЛЕЙ

А.Б. Ринкевич, Д.В. Перов, М.И. Самойлович, С.М. Клещева

# FREQUENCY DEPENDENCE OF MICROWAVE ABSORPTION COEFFICIENT FOR OPAL-BASED NANOCOMPOSITES WITH FERROSPINEL NANOPARTICLES

A.B. Rinkevich, D.V. Perov, M.I. Samoylovich, S.M. Kleshcheva

Измерены частотные зависимости коэффициента затухания электромагнитных волн в 3D-нанокомпозитах на основе опаловых матриц, содержащих наночастицы ферритов-шпинелей, в условиях магнитного резонанса.

Ключевые слова: миллиметровые радиоволны, поглощение электромагнитных волн, нанокомпозиты, ферромагнитный резонанс.

Frequency dependences of microwave absorption coefficient for opal-based 3D nanocomposites with ferrospinel nanoparticles have been measured in ferromagnetic resonance conditions.

Keywords: microwaves, electromagnetic wave absorption, ferromagnetic resonance.

Измерение коэффициентов отражения, прохождения и поглощения волн СВЧ-диапазона важно для нескольких практических приложений. Специальный интерес в этом отношении вызывают фотонные кристаллы [1]. Из литературы известно, что изучаются их свойства как при прохождении электромагнитных волн, так и при отражении. Аналитически и численно исследуется распространение электромагнитных волн в среде с отрицательным показателем преломления [2]. В частности, была решена задача о прохождении волны через пластину такой среды с демонстрацией эффекта фокусировки. Фокусировка осуществляется в ближнем поле излучения в металлизированной фотонной структуре в условиях отрицательного коэффициента преломления. В принципе, если объект сделан из материала с отрицательным коэффициентом преломления, то в идеальном случае он может стать невидимым. Дана общая формулировка задачи взаимодействия электромагнитной волны со стратифицированной средой с отрицательным коэффициентом преломления [3]. Специальное внимание уделяется изучению направленных волн в стратифицированной среде.

Опаловые матрицы считаются одними из наиболее перспективных классов наноматериалов. В настоящее время интенсивно исследуются линейные и нелинейные оптические свойства опаловых матриц, изменения коэффициента преломления, а также вариации интенсивности, поляризации и когерентности, происходящие при прохождения через матрицы мощного когерентного излучения [4]. Наибольший интерес вызывают свойства ансамблей различных микросфер и матриц как фотонных кристаллов. Введение в межсферические пустоты опаловых матриц наночастиц магнитных материалов стало одним из направлений их развития.

Высокочастотные и радиочастотные магнитные свойства ансамблей наночастиц имеют значительную специфику. Применение микроволновых методов исследования представляется

эффективным, поскольку последние дают возможность сравнительно просто оценить динамические и релаксационные параметры таких материалов. Опаловые матрицы считаются классом материалов, пригодных для создания сред с отрицательным показателем преломления. Осуществление так называемой «левой» среды с отрицательной действительной частью магнитной проницаемости возможно в области магнитных резонансов. Взаимодействие высокочастотных электромагнитных волн с магнитофотонными кристаллами, рассматриваемыми как метаматериалы, составляет наиболее актуальное направление в этой области. Обращается внимание на прикладные аспекты получения отрицательного показателя преломления на частотах миллиметрового диапазона с использованием явления магнитного резонанса [5, 6]. В [7] выполнен анализ условий существования отрицательного показателя преломления на микроволновых частотах и установлено, что допированные манганиты лантана в области магнитного резонанса являются примером материалов с отрицательным показателем преломления или двойной левой средой. Специальный класс метаматериалов составляют среды с близкой к нулю диэлектрической постоянной или так называемые ENZ (Epsilon-Near-Zero)-материалы. Эффект «сверхсвязи» (supercoupling) представляет один из ярких примеров аномального распространения волн в таких средах [8, 9]. Указанное явление представляет собой туннелирование волны через узкие каналы и изгибы, соединяющие два волновода в условиях, когда обычное прохождение волны невозможно.

В настоящей работе исследуются микроволновые резонансные явления в нанокомпозите, содержащем либо наночастицы никель-цинкового, марганец-цинкового, или кобальт-цинкового ферритов в диэлектрической матрице – решетчатой упаковке субмикронных сфер SiO<sub>2</sub>. Никельцинковый и другие ферриты-шпинели представляются подходящими материалами для заполнения благодаря удачному сочетанию свойств, таких как высокое удельное электросопротивление, малые диэлектрические потери, высокая температура Кюри и химическая стабильность.

Микроволновые свойства измерены на частотах миллиметрового диапазона. Изменения микроволнового сигнала, прошедшего через нанокомпозит, происходят в основном из-за изменения поверхностного импеданса нанокомпозита в условиях магнитного резонанса и из-за поглощения электромагнитной волны в нем. Исследованы магнитные резонансные явления в нанокомпозитах и их влияние на коэффициенты отражения и прохождения через нанокомпозит. В работе показано, что на частотах выше некоторой определенной для каждого материала наночастиц в полях, меньших резонансного, наблюдается еще и антирезонанс, который выражается в максимумах коэффициентов отражения и прохождения. Установлено, что антирезонанс соответствует минимуму коэффициента поглощения.

Анализ результатов ведется с учетом структурного и магнитного состояния материала. Осуществление эффективного взаимодействия микроволновых полей с наночастицами ферритов представляет интерес как для нахождения условий существования отрицательной действительной части магнитной проницаемости, так и для применения в электронных приборах сверхвысоких частот.

Синтез образцов опаловых матриц с диаметрами субмикронных сфер SiO<sub>2</sub> от 200 до 350 нм был описан в ряде работ, например в [10]. Нанокомпозиты с внедренными наночастицами никель-цинкового, марганец-цинкового и кобальт-цинкового ферритов были также получены мето-

дом пропитки с последующей термической обработкой. Рентгенофазовый анализ показал, что во внесенном веществе большинство рефлексов относятся к фазам типа  $(Ni_xZn_{1-x})Fe_2O_4$  и  $(Mn_xZn_{1-x})Fe_2O_4$ , имеющим кристаллическую структуру шпинели. На рис. 1 показана структура нанокомпозита с частицами никель-цинкового ферриташпинели, полученная методом электронной просвечивающей микроскопии. Частицы введенных фаз имеют неправильную форму и размеры от 5 до 70 нм. Объемная концентрация внесенных наночастиц не превышает 3–5 %. В дальнейшем будем называть внедренный материал как феррит, например, никель-цинковый  $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4$ , несмотря на возможное присутствие в нем другой магнитной фазы. Сказанное относится и к нанокомпозитам с марганец-цинковым и кобальт-цинковым ферритами.



Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение структуры нанокомпозита с частицами никель-цинковой шпинели

Магнитные измерения выполнены на установке MPMS-XL фирмы Quantum Design в интервале полей до 50 кЭ и при температурах от 2 до 300 К. Измерены кривые намагничивания и петли гистерезиса, а также температурная зависимость магнитного момента образца в поле напряженностью 10 кЭ. Магнитные свойства массивных образцов ферритов-шпинелей хорошо известны. Такие ферриты выпускаются серийно для целого ряда применений. Однако магнитные

параметры опаловых матриц, содержащих наночастицы ферритов, могут существенно отличаться от свойств массивных образцов. Основное внимание в данной работе вызывает область частот и магнитных полей вблизи условий магнитного резонанса. Поэтому наибольший интерес представляет кривая намагничивания нанокомпозитов, поскольку именно величина намагниченности определяет поле магнитного резонанса.

Кривые намагничивания для образца 3D-нанокомпозита с частицами марганеццинкового феррита  $Mn_{0,5}Zn_{0,5}Fe_2O_4$  при нескольких температурах показаны на рис. 2. Кривые намагничивания не имеют полного насыщения в полях до 50 кЭ. Кроме этого, кривые намагничивания





имеют участок быстрого возрастания намагниченности в слабых полях. Указанные особенности кривых намагничивания позволяют сделать заключение, что исследуемые материалы обладают как ферромагнитным (точнее ферримагнитным) упорядочением, так и суперпарамагнитными свойствами. Наличие суперпарамагнитных свойств исследуемых материалов не является удивительным, поскольку частицы внесенных фаз имеют размеры менее 70 нм, а некоторая их часть имеет размеры менее 10 нм.

Микроволновые измерения выполнены в частотном диапазоне 26 - 38 ГГц с использованием прямоугольных резонаторов и стандартных волноводов, работающих на моде  $TE_{10}$ . Для выполнения микроволновых измерений образец помещался в волновод (рис. 3, а) или в прямоугольный резонатор (рис. 3, б). При этом образец длинной стороной размещался вдоль оси СВЧ-тракта при размещении в резонаторе и поперек тракта при размещении в волноводе. Внешнее постоянное магнитное поле H, создаваемое электромагнитом, прикладывалось перпендикулярно волновому вектору волны q. В случае, когда образец находится в волноводе, внешнее магнитное поле лежит в плоскости образца либо параллельно, либо перпендикулярно вектору микроволнового электрического поля  $E_{-.}$ . Вектор H в этих случаях будет либо перпендикулярен микроволновому магнитному полю  $H_{-.}$ , либо будет лежать в плоскости  $H_{-.}$  соответственно. Во всем интервале частот осуществляется одномодовый режим. Для выполнения микроволновых измерений образец толщиной 1 мм помещался в волновод сечением  $7,2\times3,6$  мм. Все микроволновые эксперименты выполнены при комнатной температуре.

Необходимость использования двух методик измерения микроволновых характеристик обусловлена следующими обстоятельствами. В резонаторе возможно выполнить измерения на частотах вблизи резонансных частот резонатора, каждая из которых соответствует определенной структуре электромагнитных полей. Резонатор включен в СВЧ-тракт каскадно. В условиях магнитного резонанса резко увеличивается поглощение электромагнитной энергии; полевая зависимость амплитуды принятого сигнала определяется резонансной зависимостью мнимой части магнитной проницаемости образца от напряженности внешнего постоянного магнитного поля. Вторая методика, в которой образец помещается в поперечное сечение волновода, имеет достоинство в том отношении, что частота волны может изменяться непрерывно во всем интервале, в котором распространяется волна  $TE_{10}$ . Два варианта расположения вектора внешнего постоянного магнитного поля (варианты (а) и (б) на рис. 3, а) дают возможность реализовать различную ориентацию полей и выявить разные типы резонансов.



Рис. 3. Схема расположения образца в волноводе (а) и в резонаторе (б)

В микроволновых экспериментах с помощью измерителя КСВ и отражения P2-65 измерялись модули коэффициентов прохождения D и отражения R. Влияние внешнего постоянного магнитного поля на коэффициенты оценивалось относительным изменением во внешнем магнитном поле модуля коэффициента прохождения  $d_m = [|D(H)| - |D(0)|] / |D(0)|$  и относительным изменением модуля коэффициента отражения  $r_m = [|R(H)| - |R(0)|] / |R(0)|$ , где D(H), R(H) – коэффициенты прохождения от образца, измеренные в поле H.

Целью проведенных микроволновых измерений с нанокомпозитами с частицами ферритовшпинелей было установление типов магнитных резонансов, которые могут осуществляться в магнитных нанокомпозитах на основе опаловых матриц. Резонатор был включен в СВЧ-тракт каскадно, как это показано на рис. 3, б. При помещении образца в резонатор резонансные частоты уменьшаются, ширина резонансной линии увеличивается из-за микроволновых потерь в образце. Результаты измерения полевой зависимости амплитуды микроволнового сигнала для нанокомпозита с частицами  $Mn_{0,5}Zn_{0,5}Fe_2O_4$  показаны на рис. 4. Наблюдается одна широкая линия магнитного резонанса.

Аналогичные измерения были выполнены с нанокомпозитом, содержащим частицы никельцинкового феррита-шпинели Ni<sub>0,5</sub>Zn<sub>0,5</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, на нескольких собственных частотах резонатора. Результаты измерений приведены на рис. 5. На всех частотах в полях свыше 10 кЭ зарегистрировано резкое уменьшение прошедшего сигнала, связанное с магнитным резонансом в наночастицах феррита-шпинели. Однако поля в 12 кЭ оказалось недостаточно, чтобы достигнуть резонанса. Тем не менее, измерения показали, что измене-

1ем не менее, измерения показали, что изменения микроволнового сигнала в области резонанса велики, они достигают 50–60 %. Уменьшение прошедшего сигнала следует связать с диссипацией, вызванной увеличением мнимой компоненты эффективной магнитной проницаемости. Можно отметить, что в полях, меньших резонансного, наблюдается некоторое увеличение прошедшего сигнала. Оно вызвано уменьшением поглощения в области полей, соответствующих переходу действительной части проницаемости через нуль, то есть в области антирезонанса.

Измерения в волноводе были выполнены по схеме, показанной на рис. 3, а. Как правило, использовалась конфигурация полей  $H \perp H_{\sim}$  как более информативная. Сопоставление резуль-







Рис. 5. Полевые зависимости микроволнового сигнала, прошедшего резонатор с образцом, содержащим наночастицы Ni<sub>0,5</sub>Zn<sub>0,5</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

татов измерения полевой зависимости коэффициентов прохождения и отражения для нанокомпозита, содержащего частицы кобальт-цинкового феррита Co<sub>0,35</sub>Zn<sub>0,65</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, проведено на рис. 6. Полученные зависимости, измеренные на частотах до 30 ГГц, оказались похожи друг на друга как по величине изменений, так и по форме зависимости. На этих зависимостях присутствует только уменьшение коэффициента прохождения, вызванное резонансом. На более высоких частотах характер зависимостей становится несколько различным. Если на полевой зависимости прошедшего сигнала, по-прежнему, присутствует только резонансное уменьшение прошедшего сигнала, то в отраженном сигнале в полях, меньших резонансного, наблюдается максимум коэффициента отражения.

Полевые зависимости изменений отраженного сигнала для образца, содержащего наночастицы никель-цинкового феррита, при  $H \perp H_{\sim}$  показаны на рис. 7. Обращают на себя внимание очень большие, до 4 раз, изменения отраженного сигнала в максимуме, которые можно назвать гигантскими. Уменьшение сигнала в резонансе визуально на рис. 7 кажется менее значительным, но в действительности оно достигает -90 %. Другими словами, в области резонанса отраженный сигнал уменьшается в 10 раз.

Рассмотрим прохождение и отражение волн от слабопроводящего ферромагнитного образца, помещенного в прямоугольный волновод. Полагаем, что выбран такой интервал частот, что в волноводе может распространяться только мода  $TE_{10}$ . Длина образца вдоль оси волновода равна d, поперечные размеры волновода a и b, причем a – это большая стенка волновода. Образец полностью занимает поперечное сечение волновода, как показано на рис. 3, а. Заполненный образцом участок волновода – область 2 – имеет эквивалентное сопротивление  $Z_2$ , а незаполненные участки – сопротивление  $Z_1$ . Обозначим через  $\beta_2$  комплексную постоянную распространения,  $\beta_2 = \beta'_2 + i\beta''_2$ . Комплексные коэффициенты прохождения D и отражения R выражаются следующими формулами из [11]:

$$D = \frac{1}{ch\beta_2 d + \frac{1}{2}(\xi + \xi^{-1})sh\beta_2 d},$$
(1)

$$R = \frac{\frac{1}{2}(\xi - \xi^{-1})\operatorname{sh}\beta_2 d}{\operatorname{ch}\beta_2 d + \frac{1}{2}(\xi + \xi^{-1})\operatorname{sh}\beta_2 d},$$
(2)

где  $\xi = Z_2/Z_1$ .





Эквивалентные сопротивления для основной моды волновода TE<sub>10</sub> можно выразить через волновые сопротивления *W*<sub>1</sub> и *W*<sub>2</sub> [12]:

$$Z_{1} = \frac{\pi}{2} \frac{b}{a} W_{1}; \quad Z_{2} = \frac{\pi}{2} \frac{b}{a} W_{2},$$
  
rge  $W_{1} = 120\pi / \left[ 1 - \left(\frac{c}{2af}\right)^{2} \right]^{-\frac{1}{2}}; \quad W_{2} = 120\pi \mu_{ef} / \left[ \varepsilon_{ef} \mu_{ef} - \left(\frac{c}{2af}\right)^{2} \right]^{-\frac{1}{2}}.$ 

Здесь  $\varepsilon_{ef}$ ,  $\mu_{ef}$  – некоторые эффективные диэлектрическая и магнитная проницаемости, *c* – скорость распространения электромагнитных волн в вакууме. Отметим, что в рассматриваемом случае нанокомпозит со включениями металла не может рассматриваться как хороший проводник, поскольку глубина скин-слоя (4–5 мм на рассматриваемых частотах) значительно больше толщины образца 1 мм. Поэтому можно считать, что в наших экспериментальных условиях скинэффект в распределении электромагнитного поля проявляется слабо. Малость размеров включений (10–80 нм) по сравнению с глубиной скин-слоя дает возможность использовать приближение однородной среды с эффективными проницаемостями.

Одной из основных целей данной работы является установление условий наблюдения и физической природы максимумов коэффициента отражения и прохождения. Ранее при изложении экспериментальных результатов было показано, что максимумы наблюдаются на частотах, превышающих некоторое значение. Сопоставление данных, полученных для 3D-нанокомпозитов с частицами разных ферритов, например,  $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4$  и  $Ni_{0.35}Zn_{0.65}Fe_2O_4$  или  $Co_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4$  и  $Co_{0.35}Zn_{0.65}Fe_2O_4$ , показало, что величина этой частоты различна в каждой паре нанокомпозитов. При изложении результатов микроволновых измерений было высказано предположение, что максимум в коэффициенте отражения соответствует антирезонансу. Если это действительно так, то в явлении должны присутствовать две характерные черты: 1) максимум отражения наблюдается в области полей, где действительная часть магнитной проницаемости меняет знак;

2) максимум коэффициента отражения соответствует минимуму поглощенной мощности в образце. На образцах нанокомпозитов были измерены частотные зависимости модулей коэффициентов прохождения и отражения. Результаты для нанокомпозита, содержащего частицы марганец-цинковой шпинели Mn<sub>0,5</sub>Zn<sub>0,5</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, показаны на рис. 8.

Коэффициент прохождения с ростом частоты в целом увеличивается, а коэффициент отражения – уменьшается. Численные значения коэффициентов на рис. 8 даны по мощности. На каждой частоте это D(H = 0) и R(H = 0). Видно, что в исследованном частотном интервале эти коэффициенты одного порядка по величине.



Рис. 7. Полевая зависимость коэффициента отражения для нанокомпозита, содержащего частицы Ni<sub>0,5</sub>Zn<sub>0,5</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (толщина образца 2 мм)

То же зафиксировано для всех изученных нанокомпозитов. На рис. 8 приведена также и частотная зависимость суммы этих коэффициентов. Разность 1-[|D|+|R|] выражает долю поглощенной мощности. Ее можно выразить в децибелах и отнести на 1 мм толщины образца. Получится значение коэффициента поглощения в нулевом магнитном поле. Относительно этого значения можно отсчитывать изменения в магнитном поле. То есть для каждого значения поля H вычислять разность 1-[|D(H)|+|R(H)|] и выражать ее в дБ/мм. Результат для нанокомпозита с частицами Ni<sub>0,5</sub>Zn<sub>0,5</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> показан на рис. 9. На более низкой частоте на зависимости присутствует один максимум поглощения. Он реализуется в поле  $H \approx 9$  кЭ и соответствует магнитному резонансу. На более высокой частоте 36 ГГц максимуму поглощения предшествует минимум. Он наблюдается в поле  $H \approx 10,5$  кЭ.



Рис. 8. Частотные зависимости модулей коэффициентов прохождения и отражения по мощности, а также их суммы для 3D-нанокомпозита, содержащего частицы Mn<sub>0.5</sub>Zn<sub>0.5</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

Проведенный анализ позволяет понять. почему экспериментально измеренные полевые зависимости коэффициентов отражения и прохождения на рис. 9, 10 на низких частотах имеют сходный вид. В рассмотренной области миллиметровых волн значения этих коэффициентов, измеренные без внешнего магнитного поля, имеют один порядок величины,  $|D(0)| \approx |R(0)|$ . Резонансный вид экспериментально измеренных зависимостей  $d_m(H)$  и  $r_m(H)$  обусловлен тем, что компоненты тензора магнитной проницаемости µ и µ<sub>а</sub> при выполнении условий магнитного резонанса получают добавки, резонансным образом зависящие от напряженности магнитного поля. Соответственно резонансные добавки получат постоянная распространения В2 и отноше-

ние импедансов ξ. Резонансные добавки вызваны поглощением волны в условиях магнитного резонанса, поэтому на полевых зависимостях коэффициентов прохождения и отражения наблюдается минимум.

Магнитный резонанс соответствует минимуму коэффициента прохождения. На рис. 10 положение минимумов для расчетной и экспериментальной зависимостей близкое и приходится на область  $H \approx 8,2...8,4$  кЭ. На экспериментальной зависимости при полях, меньших поля резонанса, наблюдается максимум коэффициента прохождения, который соответствует минимуму поглощения волны, а именно антирезонансу. На частоте 26 ГГц положение максимума приходится на поле  $H \approx 3,9$  кЭ. На расчетной зависимости антирезонанс отсутствует, поскольку в использованном для расчета простом варианте теории последний не может быть получен. Для правильного описания антирезонанса требуется использовать метод расчета, предполагающий существование в проводящем ферромагнетике нескольких (трех) собственных волн. Кроме того, нужно осуществить корректный учет условий закрепления спинов на границах образца. Столь подробный расчет представляет самостоятельную сложную задачу и выходит за рамки данной статьи.

Сопоставим поле антирезонанса, за которое примем поле максимума на полевой зависимости коэффициента прохождения и поле  $H_2$ , в котором действительная часть магнитной проницаемости обращается в нуль;  $\text{Re}(\mu) = 0$ . Согласно [13] зависимость поля  $H_2$  от частоты задается соотношением

$$H_{2} = \sqrt{(\omega/\gamma)^{2} + (2\pi M)^{2}} - 2\pi M.$$
(3)

При  $f = 26 \ \Gamma \Gamma \mu H_2 = 4,13 \ \kappa \Im$ , что близко к экспериментально наблюдаемому значению поля для максимума 3,9 кЭ. В области от поля антирезонанса резонанса 3,9 кЭ до поля резонанса  $H \approx 8,5 \ \kappa \Im$  действительная часть магнитной проницаемости отрицательна. Отсюда следует, что наблюдаемый экспериментально максимум в коэффициентах прохождения и отражения действительно приходится на значение внешнего поля, в котором действительная часть магнитной проницаемости меняет знак. Зависимости действительной и мнимой частей эффективной магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля, измеренные на частоте 26  $\Gamma \Gamma \mu$  в нанокомпозите с частицами никель-цинкового феррита, показаны на рис. 11.

В целом, в данной работе изучены электромагнитные свойства 3D-нанокомпозита на основе опаловой матрицы с внедренными в межсферические пустоты наночастицами ферритовшпинелей. Экспериментально продемонстрировано эффективное взаимодействие электромагнитных волн с 3D-нанокомпозитами. В миллиметровом диапазоне изменения коэффициентов прохождения через пластину нанокомпозита и отражения от нее вызваны двумя физическими явлениями – магнитным резонансом и антирезонансом. Установлено, что спектры магнитного резонанса содержат акустическую ветвь.



Рис. 9. Полевые зависимости коэффициентов поглощения для нанокомпозита с частицами никель-цинкового феррита Ni<sub>0,5</sub>Zn<sub>0,5</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> на частотах 26 ГГц и 32 ГГц

Измерена частотная зависимость коэффициентов прохождения и отражения от нанокомпозитов при отсутствии внешнего магнитного поля. Было установлено, что в диапазоне частот от 26 до 38 ГГц коэффициент отражения в целом убывает, а коэффициент прохождения в целом возрастает при увеличении частоты волны. Разработан алгоритм расчета зависимости коэффициента прохождения от напряженности внешнего постоянного магнитного поля. Сопоставление расчетной и экспериментальной зависимостей показало, что в области магнитного резонанса, осуществляется разумное соответствие приведенных зависимостей.

Полученные результаты создают предпосылки для разработки управляемых магнитным полем высокочастотных устройств, ра-



Рис. 10. Зависимости относительного изменения модуля коэффициента прохождения от напряженности магнитного поля





бота которых будет основана на использовании микроволнового магнитного резонанса в магнитных нанокомпозитах на основе опаловых матриц. Такие устройства конструктивно достаточно просты и могут быть весьма эффективны в работе. В работе установлено, что для получения наибольших изменений микроволнового сигнала следует осуществлять ориентацию полей  $H \perp H_{\sim}$ . Рассматриваемые материалы могут найти применение при создании управляемых аттенюаторов, фазовращателей и других устройств миллиметрового диапазона.

#### Работа выполнена при частичной поддержке проекта 12-М-23-2052.

#### Литература

1. Ozbay, E. Microwave applications of photonic crystals / E. Ozbay, B. Temelkuran, M. Bayindir // Progress In Electromagnetics Research. – 2003. – Vol. 41. – P. 185–209.

2. Ziolkowski, R.W. Wave propagation in media having negative permittivity and permeability / R.W. Ziolkowski, E. Heyman // Phys. Rev. E. – 2001. – Vol. 64. – P. 056625 (1–15).

3. Kong, J.A. Electromagnetic wave interaction with stratified negative isotropic media / J.A. Kong // Progress In Electromagnetics Research. – 2002. – Vol. 35. – P. 1–52.

4. Photonic glasses / Ed. Fuxi Gan, Lei Xu. – Imperial College Press, 2006. – 460 p.

5. Negative refraction in ferromagnet-superconductor superlattices / A. Pimenov, A. Loidl, P. Przyslupski, B. Dabrowski // Phys. Rev. Lett. – 2005. – Vol. 95. – P. 247009 (1–4).

6. Magnetotunable left-handed material consisting of yttrium iron garnet slab and metallic wires / H. Zhao, J. Zhou, Q. Zhao et al. // Appl. Phys. Lett. – 2007. – Vol. 91. – P. 131107 (1–3).

7. Negative refraction observed in a metallic ferromagnet in the gigahertz frequency range / A. Pimenov, A. Loidl, K. Gehrke et al. // Phys. Rev. Lett. – 2007. – Vol. 98. – P. 197401 (1–4).

8. Silveirinha, M.G. Tunneling of electromagnetic energy through sub-wavelength channels and bends using epsilon-near-zero (ENZ) materials / M.G. Silveirinha, N. Engheta // Phys. Rev. Lett. -2006. - Vol. 97. - P. 157403.

9. Experimental verification of epsilon-near-zero metamaterial coupling and energy squeezing using a microwave waveguide / B. Edwards, A. Alu, M. Young et al. // Phys. Rev. Lett. – 2008. – Vol. 100. – P. 033903.

10. Металломагнитные диэлектрические нанокомпозиты на основе опаловых матриц / М.И. Самойлович, А.Ф. Белянин, Н.И. Юрасов и др. // XII Междунар. науч.-техн. конф. «Высокие технологии в промышленности России (Материалы и устройства функциональной электроники и микрофотоники)». – М., 2006. – С. 32–39.

11. Семенов, Н.А. Техническая электродинамика / Н.А. Семенов. – М.: Связь, 1973. – 480 с.

12. Лебедев, И.В. Техника и приборы СВЧ / И.В. Лебедев. – М.: Высш. шк., 1970. – Т. 1. – 440 с.

13. Гуревич, А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках / А.Г. Гуревич. – М.: Наука, 1973. – 591 с.

#### Поступила в редакцию 16 августа 2012 г.

Ринкевич Анатолий Брониславович. Доктор физико-математических наук, заместитель директора, Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург. Область научных интересов – электродинамика сплошных сред, теория магнитных явлений, физическая акустика, обработка сигналов и изображений. Тел.: +7(343) 378-38-95; e-mail: rin@imp.uran.ru

**Anatoly B. Rinkevich.** Professor, PhD, the deputy director, Institute of Metal Physics UB RAS, Ekaterinburg. Professional interests – electrodynamics of continua, magnetism theory, physical acoustics, signal and image processing. Tel.: +7(343) 378-38-95; e-mail: rin@imp.uran.ru

**Перов Дмитрий Владимирович.** Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург. Область научных интересов – электродинамика сплошных сред, теория магнитных явлений, физическая акустика, обработка сигналов и изображений. Тел.: +7(343) 378-36-97; e-mail: peroff@imp.uran.ru

**Dmitry V. Perov.** PhD, senior scientist of Institute of Metal Physics UB RAS, Ekaterinburg. Professional interests – electrodynamics of continua, magnetism theory, physical acoustics, signal and image processing. Tel.: +7(343) 378-36-97; e-mail: peroff@imp.uran.ru

Самойлович Михаил Исаакович. Доктор технических наук, заведующий лабораторией, ОАО ЦНИТИ «Техномаш», г. Москва. Область научных интересов – физика твердого тела, искусственные гетероструктуры. Тел.: +7(495) 146-19-42; e-mail: samoylovich@technomash.ru

**Mikhail I. Samoylovich.** Professor, PhD, the head of a laboratory of Central Research Technological Institute "Technomash", Moscow. Professional interests – solid state physics, artificial heterostructures. Tel.: +7(495) 146-19-42; e-mail: samoylovich@technomash.ru

Клещева Светлана Михайловна. Кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник ОАО ЦНИТИ «Техномаш», г. Москва. Область научных интересов – химия твердого тела, искусственные гетероструктуры. Тел.: +7(495) 146-10-95; e-mail: samoylovich@technomash.ru

Svetlana M. Kleshcheva. PhD, senior scientist of Central Research Technological Institute "Technomash", Moscow. Professional interests – solid state chemistry, artificial heterostructures. Tel.: +7(495) 146-10-95; e-mail: samoylovich@technomash.ru